



Registerauszug zum Aktenzeichen 10 2006 041 738.0

Stand am 18.05.2024
(letzte Aktualisierung in DPMAregister am 20.09.2019)

Es bestehen folgende Eintragungen:

Stammdaten

- [-----] **Schutzrechtsart:** Patent
- [-----] **Status:** Nicht anhängig/erloschen
- [21] **Aktenzeichen DE:** 10 2006 041 738.0
- [54] **Bezeichnung/Titel:** Zusammensetzung zur Beschichtung elektrischer Leiter und Verfahren zur Herstellung einer solchen Zusammensetzung
- [51] **IPC-Hauptklasse:** H01B 3/02 (2006.01)
- [22] **Anmeldetag DE:** 04.09.2006
- [43] **Offenlegungstag:** 06.03.2008
- [71/
73] **Anmelder/Inhaber:** Leibniz-Institut für neue Materialien Gemeinnützige GmbH, 66123 Saarbrücken, DE
- [-----] **Erfinder:** Albayrak, Sener, 66123 Saarbrücken, DE; Becker-Willinger, Carsten, Dr., 66130 Saarbrücken, DE; Veith, Michael, Prof. Dr., 66386 St. Ingbert, DE; Aktas, Oral Cenk, 66111 Saarbrücken, DE;
- [74] **Vertreter:** Patentanwaltskanzlei Vièl und Wieske PartGmbH, 66119 Saarbrücken, DE
- [10] **Veröffentlichte DE-Dokumente:** DE102006041738A1
- [-----] **Zustellanschrift:** Patentanwaltskanzlei Vièl und Wieske PartGmbH, 66119 Saarbrücken, DE
- [-----] **Zuständige Patentabteilung:** 45
- [57] **Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft eine Zusammensetzung zur Beschichtung elektrischer Leiter und ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Zusammensetzung.\$A Um eine Zusammensetzung zur Beschichtung elektrischer Leiter zur Verfügung zu stellen, deren Teilentladungsbeständigkeit gegenüber den Lösungen des Standes der Technik unter Erhalt einer hohen Dehnbarkeit der erzeugten Isolationsschicht signifikant erhöht ist, wird im Rahmen der Erfindung eine Zusammensetzung bestehend aus\$A - 1-50 Gew.-% Mikroteilchen mit einer gezielt eingestellten elektronischen Defektstruktur im Kristallgitter, welche eine erhöhte Polarisierbarkeit der Valenzelektronen bewirkt und\$A - einer
-

organischen und/oder organisch-anorganischen Matrix, \$A vorgeschlagen, wobei die Mikroteilchen mit der gezielt eingestellten elektronischen Defektstruktur aus Oxiden, Sulfiden, Seleniden, Telluriden der Elemente aus der Reihe Silizium, Zink, Aluminium, Zinn, Bor, Germanium, Gallium, Blei, der Übergangsmetalle sowie der Lanthaniden und Actiniden, insbesondere aus der Reihe Silizium, Titan, Zink, Yttrium, Cer, Vanadin, Hafnium, Zirkonium, Nickel und/oder Tantal aufgebaut sind, in der Weise, dass das Grundkristallgitter durch Dotierung mit entsprechenden nieder- oder höhervalenten Elementen mit Leerstellen im Kristallgitter ausgestattet ist, welche über Defektchemie (Defektstruktur) eine erhöhte elektronische Polarisierbarkeit der Mikroteilchen bewirken.

[43] Erstveröffentlichungstag: 06.03.2008

[-----] Anzahl der Bescheide: 0

[-----] Anzahl der Erwiderungen: 0

[-----] Erstmalige Übernahme in DPMAregister: 26.05.2011

[-----] Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAregister: 26.05.2011; 19.07.2011; 05.10.2011; 02.12.2011; 09.10.2012; 06.12.2012; 29.01.2013; 07.05.2013; 25.07.2013; 03.10.2013; 08.10.2013; 18.10.2013; 29.10.2013; 19.12.2013; 27.11.2018; 20.09.2019

Verfahrensdaten

Vorverfahren

[-----] Verfahrensart: Vorverfahren

[-----] Verfahrensstand: Die Anmeldung befindet sich in der Vorprüfung

[-----] Verfahrensstandstag: 04.09.2006

Vorverfahren

[-----] Verfahrensart: Vorverfahren

[-----] Verfahrensstand: Das Vorverfahren ist abgeschlossen

[-----] Verfahrensstandstag: 13.12.2006

Publikationen

[-----] Verfahrensart: Publikationen

[-----] Verfahrensstand: Offenlegungsschrift

[-----] Verfahrensstandstag: 06.03.2008

[-----] Heftnummer: 10

[-----] Jahr: 2008

[-----] Veröffentlichungsdatum: 06.03.2008

[-----] Publikationsart: Schriften

[-----] Teil: Teil 2

[10] Veröffentlichte DE-Dokumente: DE102006041738A1

Vorverfahren

[-----] Verfahrensart: Vorverfahren

[-----] Verfahrensstand: Die Anmeldung gilt wegen Nichtstellung des Prüfungsantrages als zurückgenommen

[-----] **Verfahrensstandtag:** 05.09.2013
[-----] **Heftnummer:** 51
[-----] **Jahr:** 2013
[-----] **Veröffentlichungsdatum:** 19.12.2013
[-----] **Publikationsart:** Bibliografiedaten
[-----] **Teil:** Teil 2